

■ Features 特長

- Contact Form 接点構成 1a
- Load Voltage 負荷電圧 400V Max.
- Operation LED Current 動作LED電流 5.0mA Max.
- Load Current 負荷電流 120mA Max.
- On-Resistance オン抵抗 30 Ω Max.
- Low Off-State Leakage Current 低開路時漏れ電流 1.0μA Max.
- I/O Breakdown Voltage 入出力間絶縁耐圧 3750Vrms Min.

■ Part Identification 品名構成

DIP Type DIP タイプ	SMD Type SMD タイプ		Quantity 包装数量
Stick スティック包装	Stick スティック包装	Tape & Reel テーピング包装	Stick スティック包装 97個 Tape テーピング包装 1000個
		Feed direction: Pin No. 3,4 引き出し方向: 3, 4番端子	
AB30	AB30F	AB30F-R1	AB30F-R2

■ Dimensions 外形寸法図 (Unit 単位: mm) & Terminal Identification 回路結線図

DIP dimensions 外形寸法図	SMD dimensions 外形寸法図	Terminal Identification 回路結線図
		<p>1: Anode アノード (LED) 2: Cathode カソード (LED) 3, 4: Drain ドレイン (MOS FET)</p>

Absolute Maximum Ratings 絶対最大定格 (Ambient Temperature 周囲温度 : 25)

Item 項目		Symbol 記号	Value 規格値
Input 入力	Continuous LED Current 繰り返しLED順電流	I _F	50mA
	Peak LED Current ピークLED電流 (f=100Hz, duty=1%)	I _{FP}	500mA
	LED Reverse Voltage LED逆電圧	V _R	5V
	Input Power Dissipation 許容損失	P _{In}	75mW
Output 出力	Load Voltage 負荷電圧	V _L	400V(AC peak or DC)
	Load Current 負荷電流	I _L	120mA
	Peak Load Current ピーク負荷電流 (1ms, 1shot)	I _{Peak}	0.6A
	Output Power Dissipation 出力損失	P _{Out}	450mW
Total Power Dissipation 全損失		P _T	500mW
I/O Breakdown Voltage 入出力間絶縁耐圧		V _{I/O}	3750Vrms
Operating Temperature 使用周囲温度		T _{opr}	- 40 ~ +85
Storage Temperature 保存周囲温度		T _{stg}	- 40 ~ +100

Electrical Specifications 電気的特性 (Ambient Temperature 周囲温度 : 25)

Item 項目		Symbol 記号	MIN.	TYP.	MAX.	Units 単位	Conditions 測定条件
Input 入力	LED Forward Voltage LED順方向電圧	V _F	1.0		1.5	V	I _F =10mA
	Operation LED Current 動作LED電流	I _{F on}		0.5	5.0	mA	
	Recovery LED Voltage 復帰LED電圧	V _{F off}	0.5			V	
Output 出力	On-Resistance オン抵抗 Drain to Drain ドレイン ドレイン間	R _{On}		24	30		I _F =10mA, I _L =Rating Time to flow is within 1sec. 通電時間1秒以内
	Off-State Leakage Current 開路時漏れ電流	I _{Leak}			1.0	μA	V _L =400V
	Output Capacitance 出力間容量	C _{Out}		115		pF	V _L =0V, f=1MHz
Transmission 伝達	Turn-On Time 動作時間	T _{On}		0.2	1.0	ms	I _F =10mA, I _L =Rating
	Turn-Off Time 復帰時間	T _{Off}		0.03	1.0	ms	
Coupled 結合	I/O Insulation Resistance 入出力間絶縁抵抗	R _{I/O}	10 ¹⁰				
	I/O Capacitance 入出力間容量	C _{I/O}		1.3		pF	f =1MHz